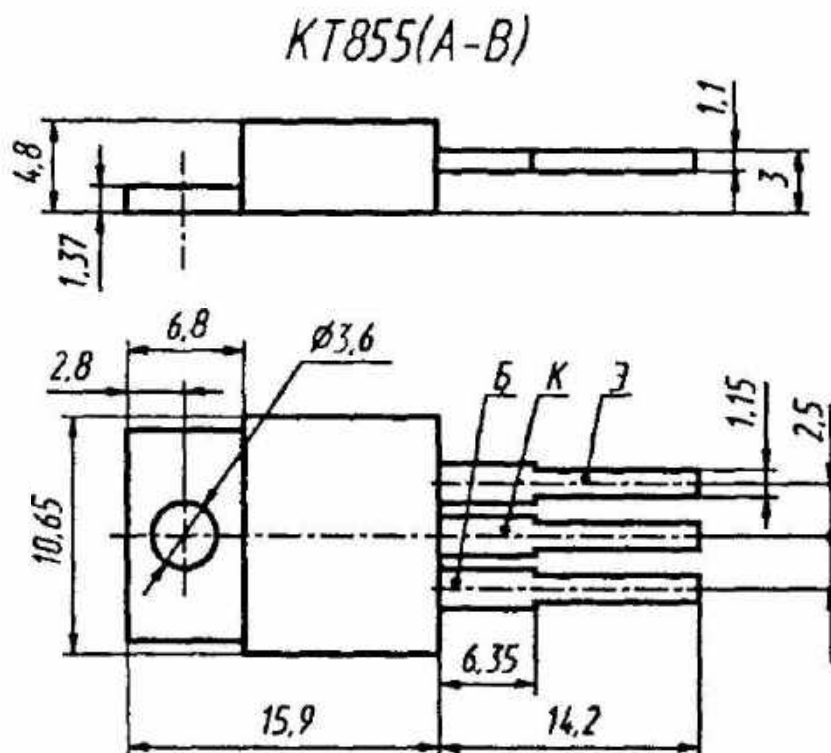


КТ855А, КТ855Б, КТ855В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры $p-n-p$ усилительные. Предназначены для применения в преобразователях, линейных стабилизаторах напряжения. Корпус пластмассовый с жесткими выводами.

Масса транзистора не более 2,5 г.

Изготовитель — акционерное общество «Кремний», г. Брянск.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КЭ} = 4$ В, $I_K = 2$ А, не менее:

КТ855А, КТ855Б	20
КТ855В	15

Граничное напряжение при $I_B = 0,05$ А, $L = 160$ мГн, не менее:

КТ855А	200 В
КТ855Б, КТ855В	150 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_K = 2$ А, $I_B = 0,4$ А, не более

1 В

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = U_{КБ, \text{МАКС}}$, не более:

КТ855А, КТ855В	1 мА
КТ855Б	0,1 мА

Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 5 \text{ В}$,
не более:

КТ855А, КТ855В	5 мА
КТ855Б	0,1 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база,
коллектор—эмиттер, при $R_{бэ} \leq 10 \text{ Ом}$:

КТ855А	200 В
КТ855Б, КТ855В	150 В

Постоянное напряжение база—эмиттер..... 5 В

Постоянный ток коллектора 5 А

Постоянный ток базы 1 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллек-
тора при $T_K = -40...+25 \text{ }^\circ\text{C}$:

с теплоотводом	40 Вт
без теплоотвода	1,2 Вт

Температура p - n перехода $+150 \text{ }^\circ\text{C}$

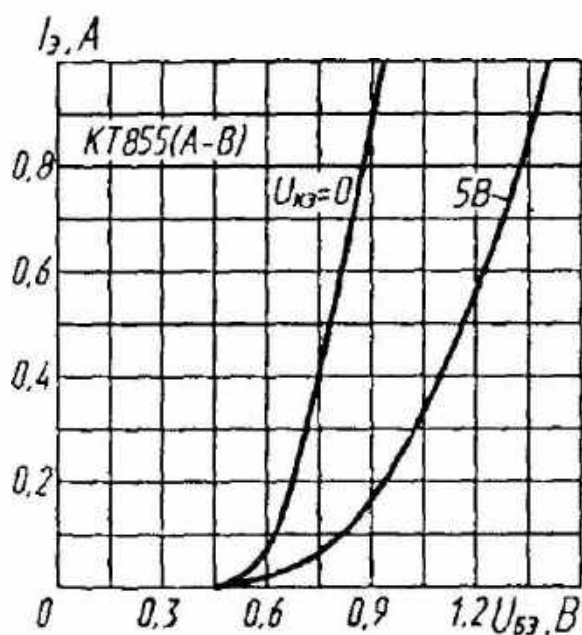
Температура окружающей среды $-40...T_K =$
 $= +100 \text{ }^\circ\text{C}$

Допускается одноразовый изгиб выводов транзисторов не ближе 2,5 мм от корпуса под углом 90° с радиусом закругления не менее 2,5 мм. При этом должны приниматься меры, исключающие передачу усилий на корпус. Изгиб выводов в плоскости выводов не допускается.

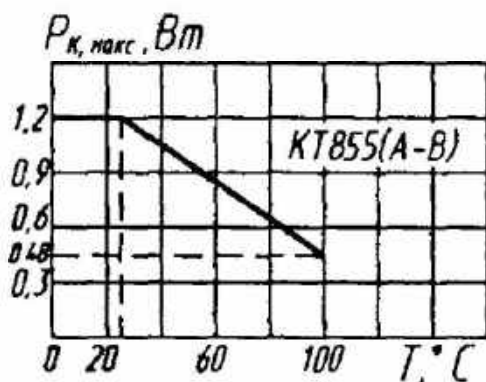
Пайка выводов транзистора допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора при температуре не более $+260 \text{ }^\circ\text{C}$ в течение не более 5 с. Допускается пайка волной припоя при температуре не более $+240 \text{ }^\circ\text{C}$.

Запрещается припайка основания транзистора к теплоотводу.

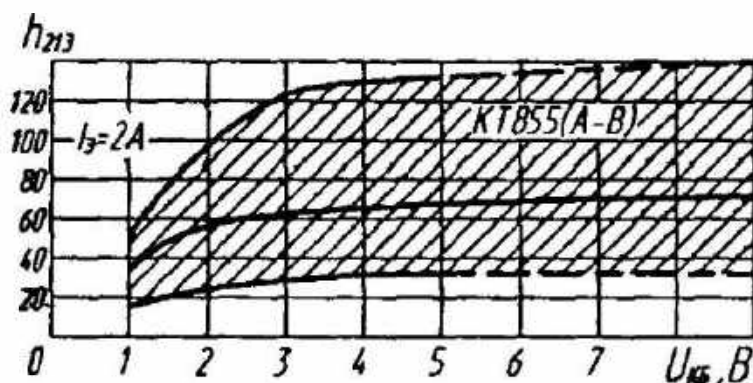
Допустимое значение статического потенциала 1000 В.



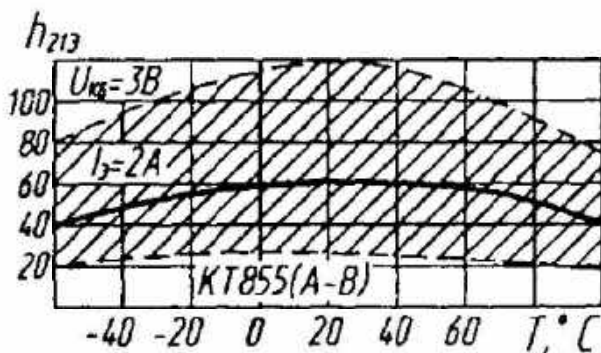
Зависимости тока эмиттера от напряжения база—эмиттер



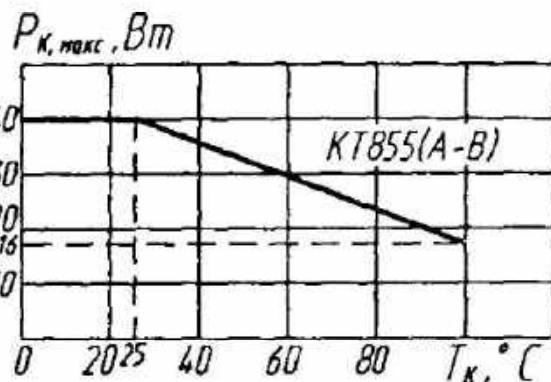
Зависимость максимально допустимой постоянной рассеиваемой мощности коллектора от температуры



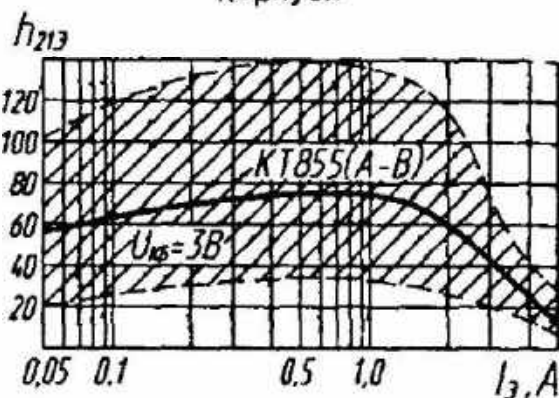
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от напряжения коллектор—база



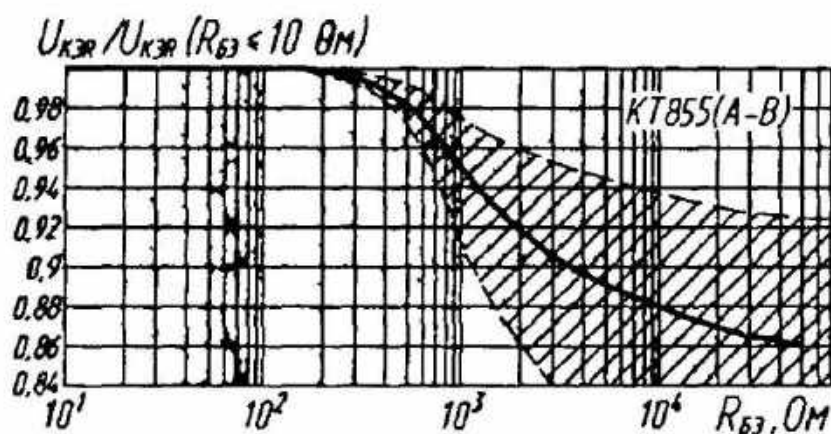
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры



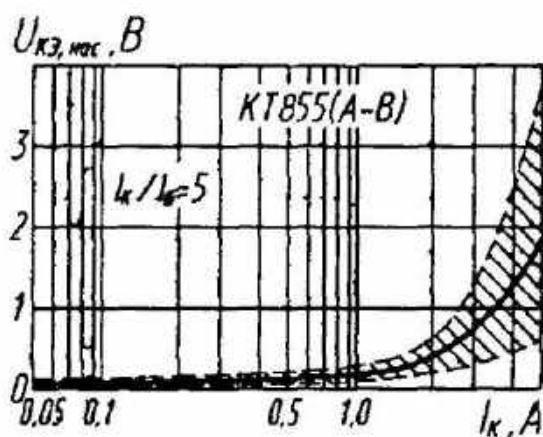
Зависимость максимально допустимой постоянной рассеиваемой мощности коллектора от температуры корпуса



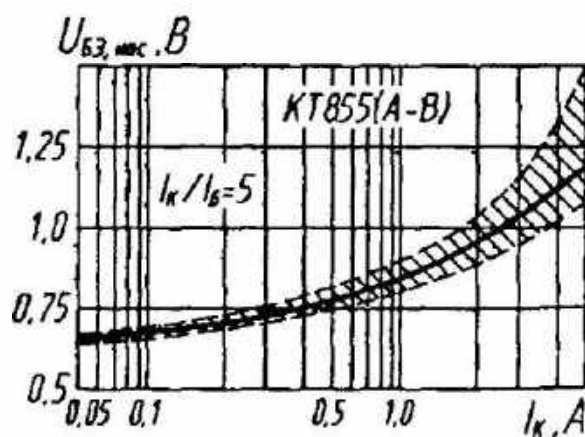
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зона возможных положений зависимости напряжения коллектор—эмиттер от сопротивления база—эмиттер

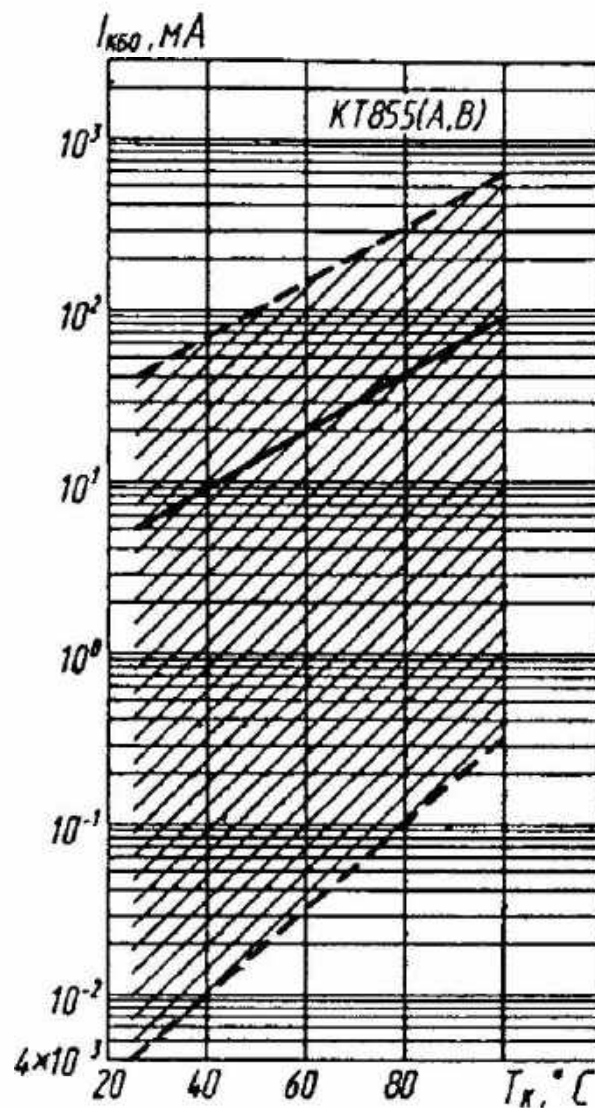


Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока коллектора

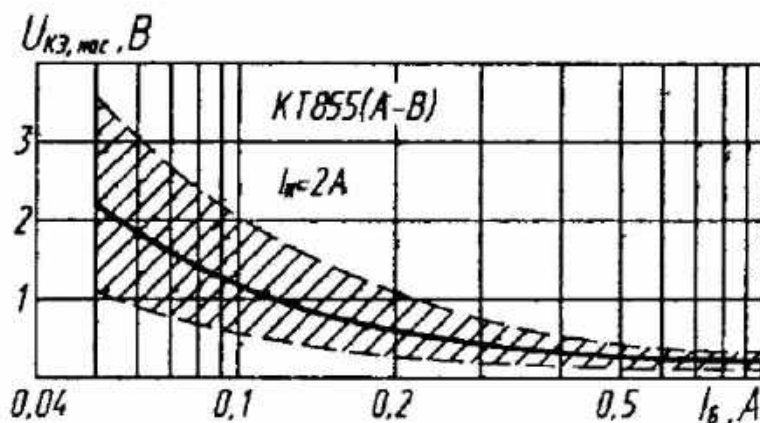


Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения база—эмиттер от тока коллектора

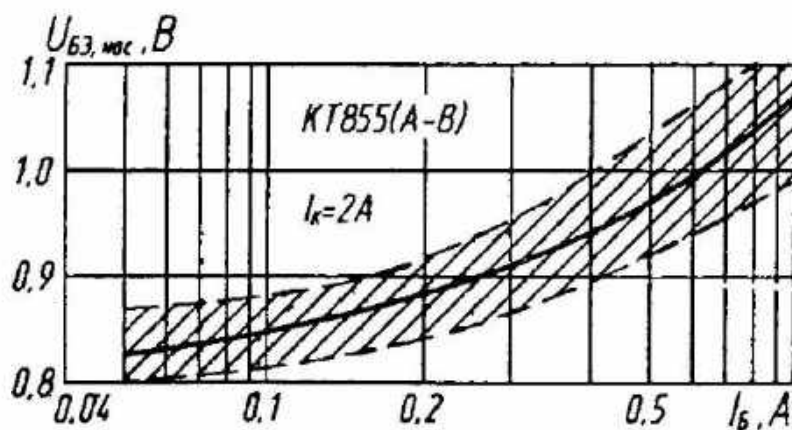
Зона возможных положений зависимости обратного тока коллектора от температуры корпуса

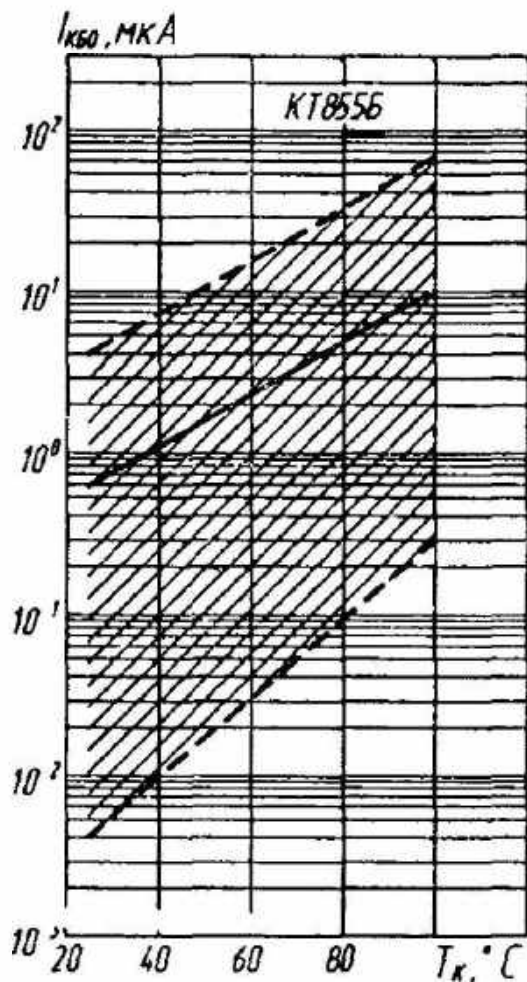


Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения коллектор—эмиттер от тока база

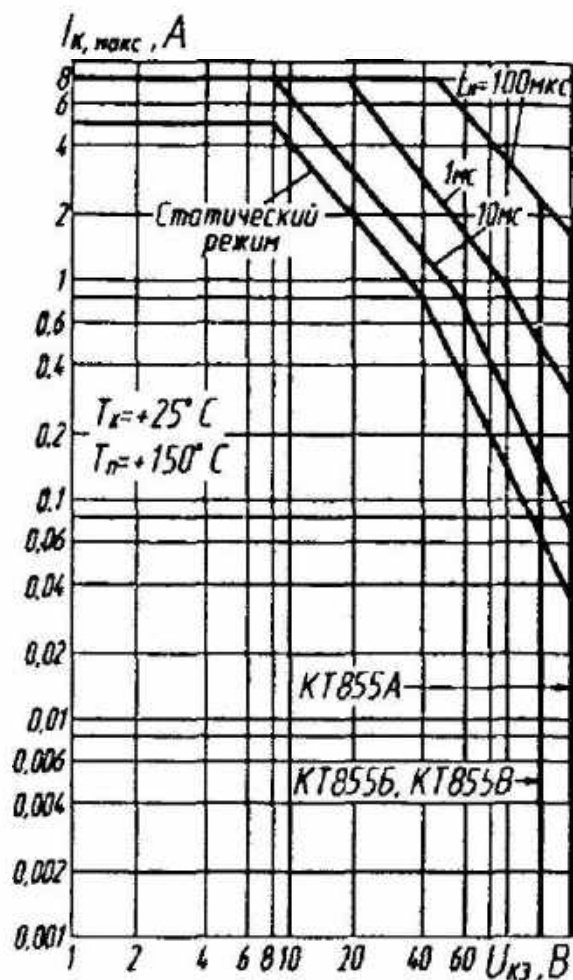


Зона возможных положений зависимости напряжения насыщения база—эмиттер от тока база





Зона возможных положений зависимости обратного тока коллектора от температуры корпуса



Области максимальных режимов